

2SD261

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波電力増幅用 / Audio Frequency Power Amplifier

特 徴 / FEATURES

- ・低電源電圧動作ラジオ、カセットなどの低周波出力用に最適です。
- ・B級プッシュプルで低周波出力2.0W程度を得ることができます。
- ・直流電流増幅率が大きく直線性がすぐれています。
- ・2SA643とコンプリメンタリで使用できます。

Suitable for output applications of 2W portable radios and cassette recorders in class B push-pull applications.

Excellent h_{FE} linearity and high DC current gain.

$h_{FE}=140$ @ $V_{CE}=1V$, $I_C=0.1A$.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	0.5	A
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(Pulse)^*}$	0.7	A
全損失	P_T	0.5	W
ジャンクション温度	T_J	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ C$

* $PW \leq 10ms$, duty cycle $\leq 50\%$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

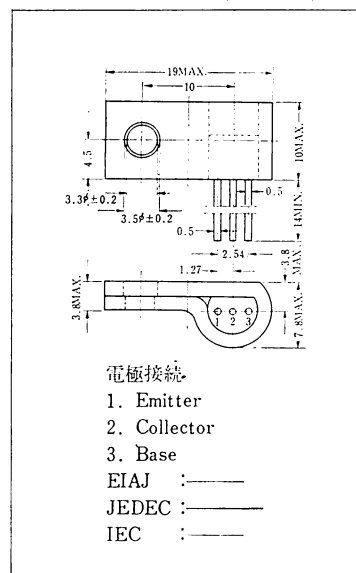
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25V$, $I_E=0$			0.2	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0V$, $I_C=0$			0.2	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CB}=1.0V$, $I_C=0.1A^*$	60	140	285	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=1.0V$, $I_C=0.5A^*$	50	90		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.5A$, $I_B=0.05A^*$		0.18	0.60	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0V$, $I_E=-10mA$		120		MHz

* パルス測定 / Pulsed

h_{FE} 区分 / h_{FE} Classification

$h_{FE1}/S: 60 \sim 95$ $W: 80 \sim 120$ $R: 100 \sim 150$ $V: 125 \sim 190$ $Q: 150 \sim 230$ $P: 185 \sim 285$

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (T_a=25°C)

